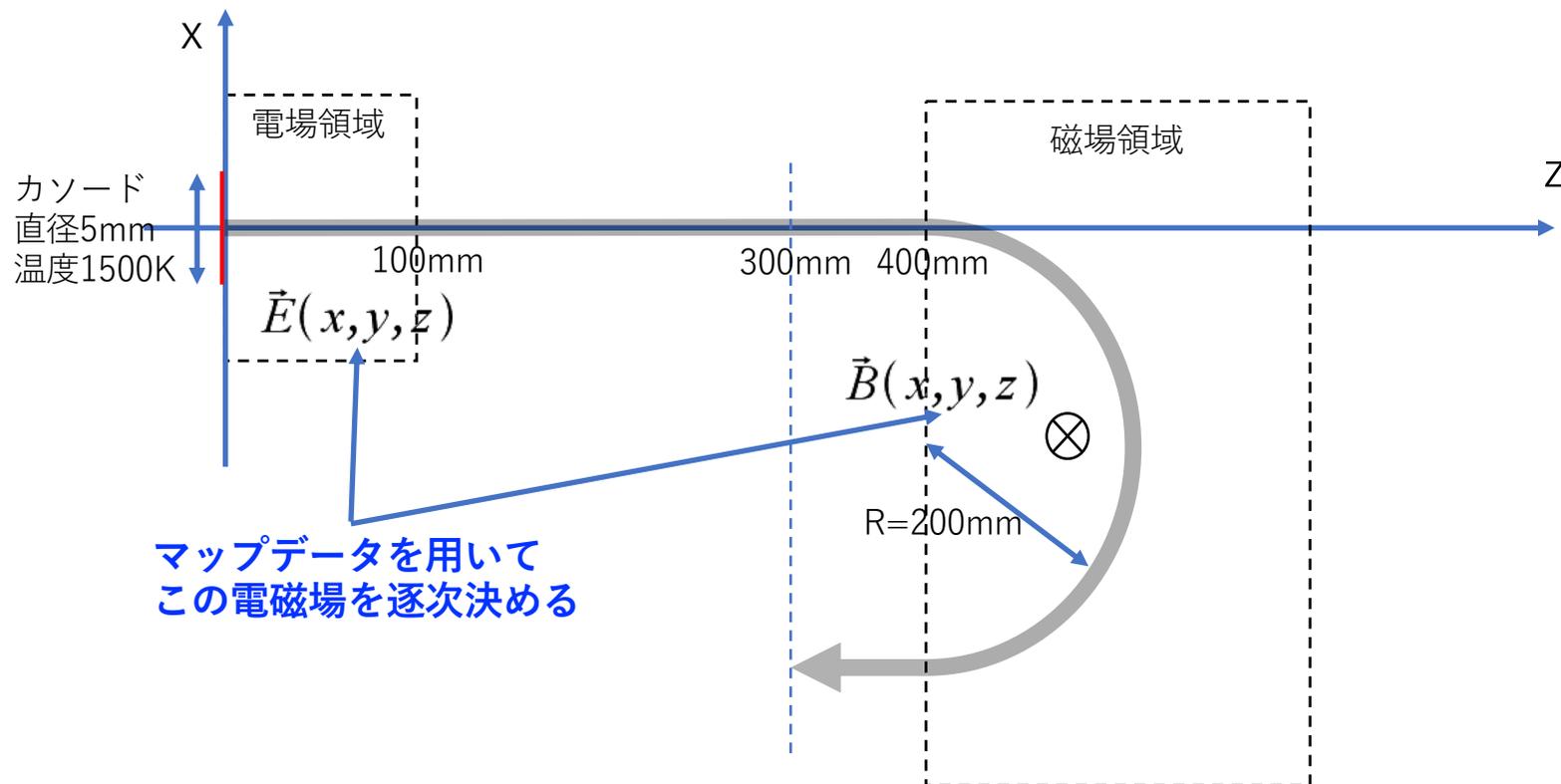
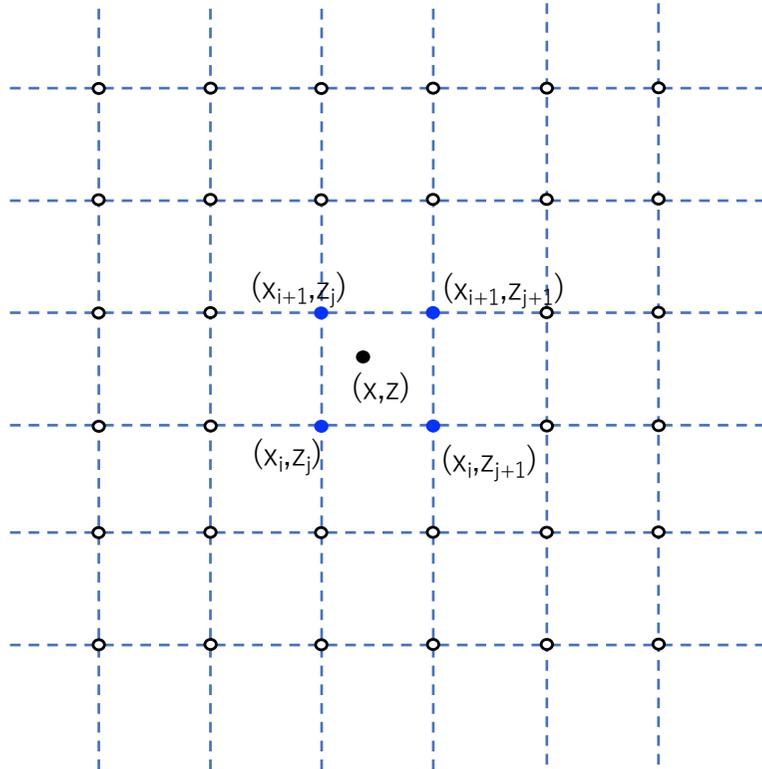


電磁場マップデータから任意の位置(x,z)における電磁場を求める

静電磁場だが位置の関数として変化する電磁場

有限要素法による計算、または実測定によって得られた離散的電磁場データを用いて
いかにして任意の位置(x,z)における電磁場の値をより正しくもとめるか





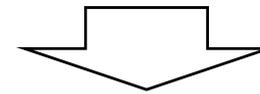
電磁場を計算すべき座標はメッシュのノードとは限らない

(x, z) の直近の周囲のデータを用いて補間内挿する

ローカルなメッシュ内でのみ成り立つ関数を求める
ただしフィッティングではない

内挿した電磁場（関数）は隣のノードとなめらかに接続

各ノードのデータを完全に信用する

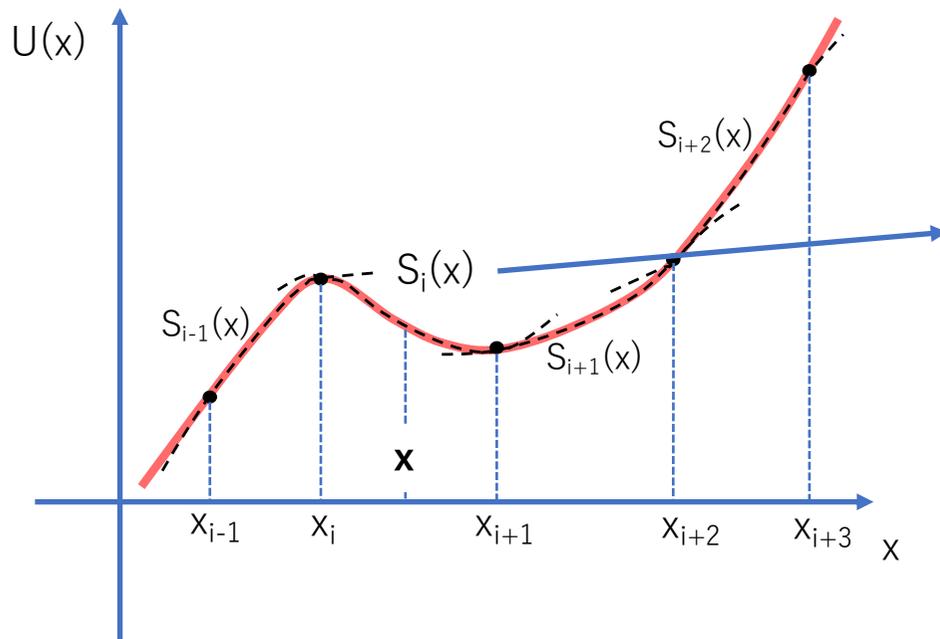


補間法

Lagrange補間法、Newton補間法、Gauss補間法、**スプライン補間法**、etc

このような補間計算をプログラムに組み込み、Runge-Kutta計算において
1ステップごとに逐次計算を行いその都度電磁場を計算する

スプライン補間法 (区分的多項式：一般に3次多項式を用いる)



$S_i(x)$ は3次多項式

範囲 (x_i, x_{i+1}) でのみ成り立つ補間関数

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

連続の条件

- ① $S_i(x_i) = U(x_i) = a_i$
ノードではデータ $U(x_i)$ に等しい
- ② $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1}) = U(x_{i+1}) = a_{i+1}$
隣のノードと連続する
- ③ $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}) = b_{i+1}$
一階微分が連続
- ④ $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1}) = c_{i+1}$
二階微分が連続

データは $n+1$ 個 ($i=0\sim n$) ある場合、各区間のスプライン関数 $S_i(x)$ の係数 (a_i, b_i, c_i, d_i) の関係式は

$$\textcircled{1} \quad a_i = U(x_i)$$

$$\textcircled{2} \quad a_{i+1} = a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 \quad (h_i = x_{i+1} - x_i, a_n = U(x_n))$$

$$\textcircled{3} \quad b_{i+1} = b_i + c_i h_i + d_i h_i^2 \quad (b_n = S'_n(x_n))$$

$$\textcircled{4} \quad c_{i+1} = c_i + d_i h_i \quad \left(c_n = \frac{S''_n(x_n)}{2} \right)$$

これらの式から b_i と d_i を消去してまとめると

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_i + h_{i-1})c_i + h_i c_{i+1} = \frac{3(a_{i+1} - a_i)}{h_i} - \frac{3(a_i - a_{i-1})}{h_{i-1}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ h_0 & 2(h_1 + h_0) & h_1 & & 0 \\ \vdots & h_1 & 2(h_2 + h_1) & h_2 & 0 \\ & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & & & h_{n-2} & 2(h_{n-1} + h_{n-2}) & h_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3(a_2 - a_1)}{h_1} - \frac{3(a_1 - a_0)}{h_0} \\ \frac{3(a_3 - a_2)}{h_2} - \frac{3(a_2 - a_1)}{h_1} \\ \vdots \\ \vdots \\ \frac{3(a_n - a_{n-1})}{h_{n-1}} - \frac{3(a_{n-1} - a_{n-2})}{h_{n-2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

逆行列を求めて c_i ベクトルを決めると上の①～④によりその他の係数が決まる

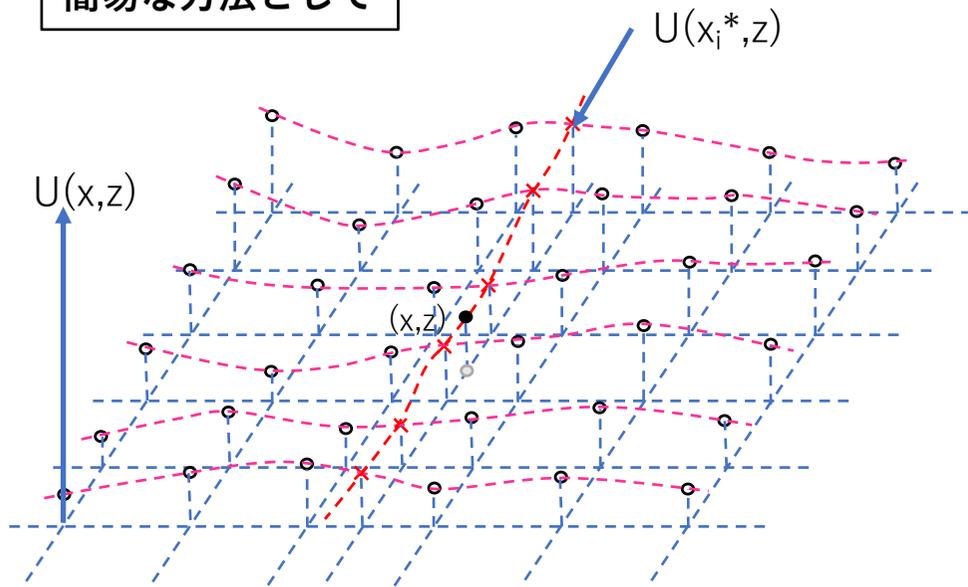
二次元マップのデータから補間するには

真っ当にやろうとすると、二次元 3 次多項式 $S_{ij}(x, z) = \sum_{k=1}^4 \sum_{l=1}^4 c_{ij}(k, l)(x - x_i)^{k-1} (z - z_j)^{l-1}$

を用いて同じことをすれば良い (項が多くてかはり煩雑、真っ当にこれをするプログラムはすぐに見つけれられる)

必要と条件に応じて

簡易な方法として



例

- ① 水平軸(z)に沿って 印の座標における $U(x_i^*, z)$ 値を求める
 - ② その値を使って垂直軸(x)にそって $U(x, z)$ を求める
- 求めた 3 次関数は x の関数となる

$$S_i(x)$$

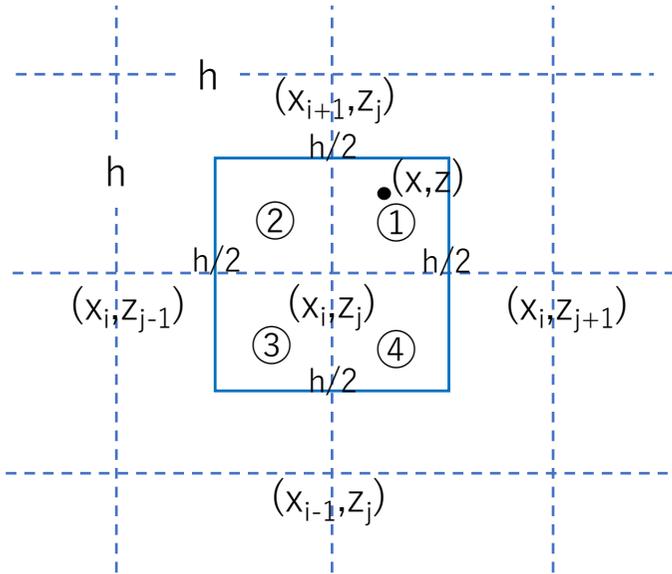
$S(x)$ が静電ポテンシャルなら、x 方向の電場は

$$E_x = -\frac{\partial S}{\partial x}$$

- ③ ①、②を順序を変えて同じことをして $S(z)$ を求めれば z 方向の電場は

$$E_z = -\frac{\partial S}{\partial z}$$

正方格子 (メッシュ) であれば



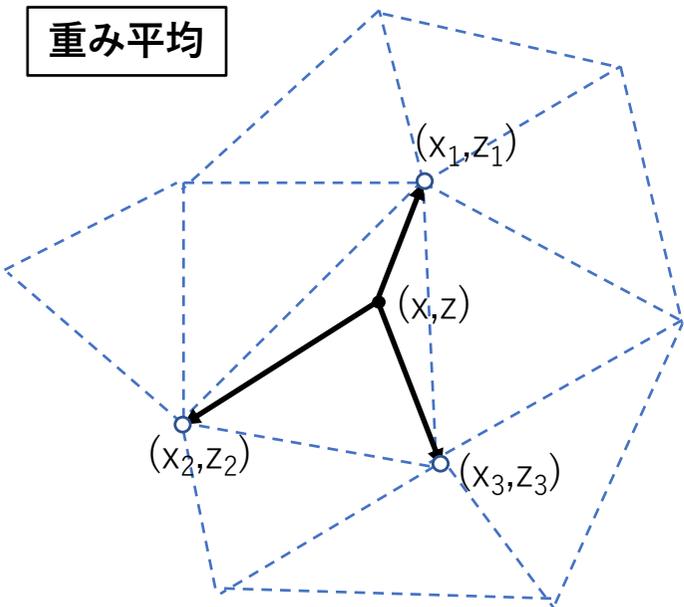
直近のノード (x_i, z_j) の周囲のメッシュ格子の中の $h/2$ で囲まれた領域を①～④に分割して考える

(x, z) が①領域にある場合

$$U(x, z) = U(x_i, z_j) + \frac{U(x_{i+1}, z_j) - U(x_i, z_j)}{h}(x - x_i) + \frac{U(x_i, z_{j+1}) - U(x_i, z_j)}{h}(z - z_j)$$

②～④も同様

重み平均



(x, z) 近傍の点 (最低直近の3点) の重み平均をとる重みはいろんな取り方がある。

(距離の重み) $w_k = \frac{1}{\sqrt{(x - x_k)^2 + (z - z_k)^2}}$

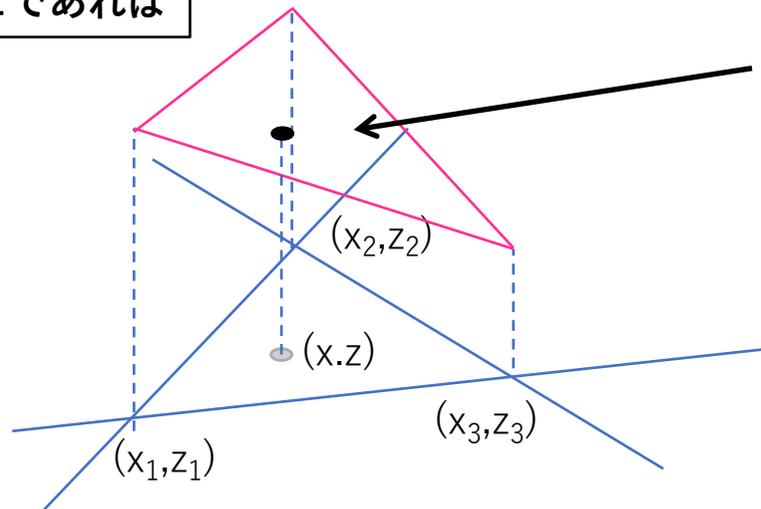
$$U(x, z) = \frac{\sum_k w_k U(x_k, z_k)}{\sum_k w_k}$$

周囲の点の数を増やすとより滑らかな接続で計算できる

さらに簡易な方法

周囲との連続条件を考慮していないのでエラーの蓄積が増加するが、メッシュが十分小さければ概ね問題ない

三角メッシュであれば

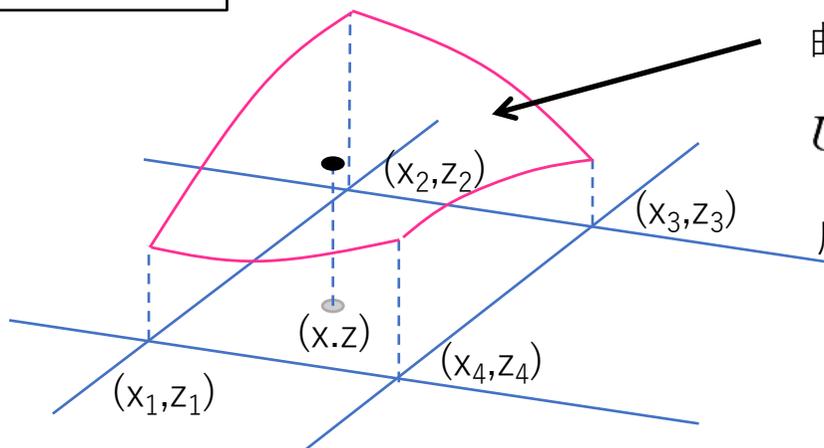


平面の方程式

$$U(x, z) = ax + bz + c$$

周囲 3 点とその $U(x_i, z_i)$ から (a, b, c) を決定

四角メッシュであれば



曲面の方程式 (干渉項を入れて)

$$U(x, z) = ax + bz + cxz + d$$

周囲 4 点とその $U(x_i, z_i)$ から (a, b, c, d) を決定